

# 「先端デバイス研究部門 2013年度 先端研究セミナー」プログラム

日時：2013年10月19日(土) 11:00-12:30(ADL教員会議)、12:30より受付、13:00-16:45(研究成果報告)

場所：東京理科大学 葛飾キャンパス 講義棟3階 307(セミナー会場)、306 + 308(ポスター発表会場)

時間	区分	整理番号	発表者	発表者	タイトル
12:30	受付開始(307教室前にて)				
13:00	はじめに	O-01	大川和宏		本セミナーの主旨
13:05	研究紹介 講義棟 3階 307	O-02	大川和宏	大川研	窒化物半導体による酸化還元デバイス
13:15		O-03	橋爪洋一郎	岡村研	強誘電体と金属の接合系におけるポテンシャル構造とその効果についての理論的解析
13:25		O-04	趙新為	趙研	Rare Earths Doped Oxide Semiconductors and Their Devices Applications.
13:35		O-05	藤代博記	藤代研	ミリ波・テラヘルツ波トランジスタの開発
13:45		O-06	飯田努	飯田研	環境低負荷熱電変換材料の自動車への応用
13:55		O-07	西尾圭史	西尾研	ガスクロミックを利用した水素センサの開発
14:05		休憩(25分)			
14:30 ~ 16:45	講義棟3階 306	P-01	塩濱健一, 内田大介, 大川和宏	大川研	InGaN光電極長波化に向けた研究
		P-02	内田大介, 萩田太郎, 大川和宏	大川研	GaN光電極のモジュール大型化
		P-03	大原航, 大川和宏	大川研	窒化物半導体光電極の助触媒担持による効果
		P-04	林秀樹, 塩濱健一, 大川和宏	大川研	InGaN/BGaN量子井戸構造LEDの作製と評価
		P-05	王雅欣, 林秀樹, 大川和宏	大川研	In incorporation of InGaN based LEDs on GaN substrates with various planes
		P-06	黒田竜之介, 平原颯太, 大川和宏	大川研	発光量子効率測定装置
		P-07	平原颯太, 植竹勇介, 大川和宏	大川研	L-HASTを用いたITOの透過率の向上
		P-08	大塚尚之	岡村研	Resistance Switching Effect of Ferroelectric Pb(Zr, Ti)O <sub>3</sub> Thin Films
		P-09	臼井翔吾	岡村研	Fabrication of FTJ devices using ultrathin VDF/TrFE copolymer
		P-10	片山美季	岡村研	表面プラズモン励起に対する自発分極の影響
		P-11	信平雄太	岡村研	反強誘電体薄膜を用いた定電圧コンデンサー
		P-12	倉持裕介	岡村研	化学溶液堆積法による(Pb,La)(Zr,Ti)O <sub>3</sub> 巨大結晶粒薄膜の作製と電気特性評価
		P-13	山形直也	岡村研	AFMを用いたPb(Zr,Ti)O <sub>3</sub> 薄膜の圧電特性評価と基板拘束の影響の検討
		P-14	中川佑太	岡村研	Control of Higher Order Structures of VDF/TeFE Copolymer Thin Films and Their Ferroelectric Properties
		P-15	鳥山真	岡村研	大変形させたPVDF圧電ポリマーフィルムが発電特性
		P-16	岡本純平	趙研	Fabrication Characterization of magnetic semiconductors.
		P-17	加藤幹大, 西村未来	趙研	Fabrication of Graphene and Graphite Thin Films from Organic Solutions.
		P-18	宇木権一	趙研	AFM Induced Local Anodic Oxidation of HOPG.
		P-19	田中翔太, 金相澈	趙研	Development of Transparent Solar Cells.
		P-20	山口竜典	趙研	Electrical and Optical Properties of Na-doped NiO Thin Films.
	P-21	岡本透, 木村友二, 石井たから	趙研	Photocatalytic Effect of ZnO-based Thin Film.	
	P-22	相澤豊, 三留杏	趙研	Formation and Cathodoluminescence of AlN Nanowires.	
	P-23	長井彰平	藤代研	Frequency Limits of Nanoscale HEMTs with Various Channel Materials	
	P-24	戸島拓也, 谷村大樹	藤代研	PZT/GaN MFS構造における分極特性と内部現象の理論的解析	
	P-25	大浜諒子	藤代研	Comparative Study on Nano-Scale III-V Double-Gate MOSFETs with Various Channel Materials	
	P-26	前田章臣	藤代研	次世代高周波デバイス実現に向けたInSb系HEMTの作製と評価	
	P-27	戸田隆介	藤代研	Ga誘起Si(111)再構成表面上GaSbナノ構造の成長形態の温度依存性	
	P-28	後藤高寛	藤代研	真空アニールがAl <sub>2</sub> O <sub>3</sub> /GaSb MOS界面に与える影響	
	P-29	鈴木貴大	安藤研	Preparation of CuInSe <sub>2</sub> Thin Films by Spin-coating Method Using the Nanoparticles of CuInSe <sub>2</sub> .	
	P-30	加藤公亮	飯田研	Deterioration at elevated temperatures of Sb-doped Mg <sub>2</sub> Si dependent on plasma activated sintering process	
	P-31	下館彩乃	飯田研	Influences on thermoelectric properties by coinorporation of impurities in Mg <sub>2</sub> Si	
	P-32	山崎涼	飯田研	Fabrication process of bulk Sb-doped n-type Mg <sub>2</sub> Si containing nanostructured elements prepared by plasma activated sintering	
	P-33	近藤駿介	飯田研	Mg-Si-C系熱電変換材料の合成と熱電特性	
	P-34	小林大輝	飯田研	排熱発電モジュールと低温及び高温側接触熱抵抗の低減	
	P-35	森岡駿介	飯田研	第一原理計算によるMg-Si系熱電変換材料のバンド構造およびドーピング効果	
	P-36	三上那津子	西尾研	NaxCo <sub>2</sub> O <sub>4</sub> のNa量xによる熱電特性の評価と最適化	
	P-37	宮本徳二	西尾研	メカノケミカル処理を前段階としたマグネシウムシリサイドの合成と熱電性能評価	
	P-38	永井健真	西尾研	熱電変換Ca <sub>3</sub> Co <sub>4</sub> O <sub>9</sub> 焼結体の径の違いによる配向度と性能変化	
	P-39	今村駿二	西尾研	Pt/WO <sub>3</sub> 薄膜を用いた光・電気シナジセンサの開発	
	P-40	佐々木あす未	西尾研	SPSを応用したMg <sub>2</sub> Siの合成	